

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年9月21日(2006.9.21)

【公開番号】特開2006-196922(P2006-196922A)

【公開日】平成18年7月27日(2006.7.27)

【年通号数】公開・登録公報2006-029

【出願番号】特願2006-72498(P2006-72498)

【国際特許分類】

H 01 L 23/12 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/12 501 T

【手続補正書】

【提出日】平成18年4月13日(2006.4.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

薄いステンレス鋼板からなる可撓性平板状の金属基板に、パターニングされた金属層を形成した電着フレームを形成する工程と、

前記電着フレームのパターニングされた前記金属層に複数の半導体素子を隣接して搭載する工程と、

前記パターニングされた金属層に搭載される各半導体素子間に形成された外部導出用の金属層に、前記隣接する各半導体素子の電極パッドをワイヤで所定間隔を設けて電気的に共通接続するワイヤボンディング工程と、

前記電着フレームに搭載されて配線がなされた半導体素子を樹脂封止する樹脂封止工程と、

樹脂封止体から前記金属基板を剥離する工程と、

を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】

金や金の合金からなる金属膜を成膜した後、金属層を形成してあって、金属膜により金属層及び切断マークをマトリックス状に形成し、且つ切断マークは金属層に近接形成していることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】

切断マークの間により切断部位が設定され、切断部位を切断することによって金属層8aの中央部が切断されることを特徴とする請求項1または2に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】

金属基板を一方の金型として樹脂封止することを特徴とする請求項1ないし3に記載の半導体装置の製造方法。